

ГТ404А, ГТ404Б, ГТ404В, ГТ404Г

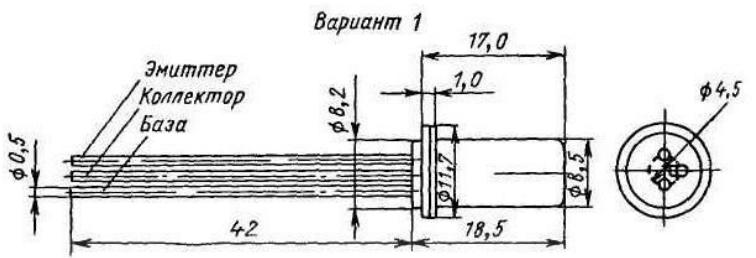
Электрические параметры

Транзисторы германиевые сплавные *n-p-n* усилительные низко частотные маломощные

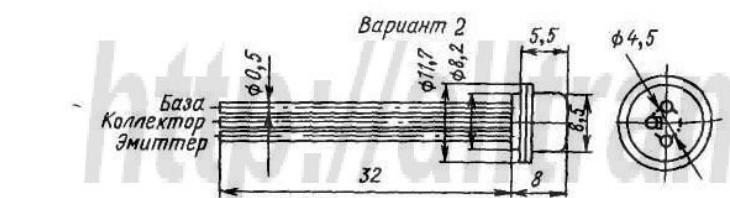
Предназначены для применения в выходных каскадах усилителей низкой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами в двух вариантах. Обозначение типа приводится на корпусе

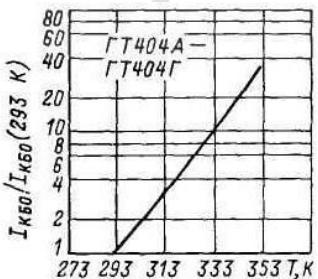
Масса транзистора вариант 1 – не более 5 г, вариант 2 – не более 2 г



Вариант 1



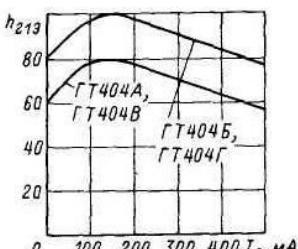
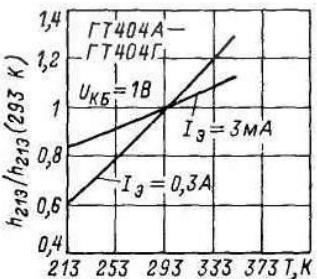
Вариант 2



Зависимость относительного обратного тока коллектора от температуры.

Зависимость относительного статического коэффициента передачи тока от температуры.

Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера.



Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 1$ В, $I_E = 3$ мА

ГТ404А, ГТ404В	30 – 80
ГТ404Б, ГТ404Г	60 – 150

Коэффициент линейности $K_t = (h_{213} \text{ при } I_E = 3 \text{ мА})/(h_{213} \text{ при } I_E = 300 \text{ мА})$	0,6 – 1,5
--	-----------

Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{KB} = 1$ В, $I_E = 3$ мА не менее	1 МГц
---	-------

Прямое падение напряжения на эмиттерном переходе при отключенному коллекторе, $I_E = 2$ мА не более	0,3 В
---	-------

Обратный ток коллектора при $U_{KB} = 10$ В, обратный ток эмиттера при $U_{BE} = 10$ В не более	25 мА
---	-------

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{BE} = 200$ Ом

ГТ404А, ГТ404Б	25 В
ГТ404В, ГТ404Г	40 В

Постоянный ток коллектора	0,5 А
-------------------------------------	-------

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = 298$ К

вариант 1	0,6 Вт
вариант 2	0,3 Вт

Temperatura перехода	358 К
--------------------------------	-------

Тепловое сопротивление переход-среда

вариант 1	0,1 К/мВт
вариант 2	0,15 К/мВт

Temperatura окружающей среды От 233 до 328 К

Примечания 1. Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт, при $T = 298 \div 328$ К определяется по формуле

$$P_{K \max} = (358 - T)/R_{T \text{ п-с}}$$

2. Допускается производить соединения выводов транзисторов с элементами схемы на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора любым способом (пайка, сварка и т.п.) при условии соблюдения следующих требований: за все время соединения температура в любой точке корпуса транзистора не должна превышать максимально допустимую температуру окружающей среды. Температура пайки не должна превышать 558 К.

Изгиб выводов должен производиться на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора. При включении транзистора в электрическую цепь вывод коллектора должен присоединяться последним и отключаться первым.